2N6424
2N6425

SILICON
PNP POWER TRANSISTORS

TO-66 CASE

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6424 and 2N6425 are silicon PNP power transistors designed for high speed switching and high voltage amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_C=25°C)	**SYMBOL**	**2N6424**	**2N6425**	**UNITS**
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	250	325	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	225	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0		V
Continuous Collector Current	I_C	1.0		A
Peak Collector Current	I_{CM}	2.0		A
Continuous Base Current	I_B	0.5		A
Peak Base Current	I_{BM}	1.0		A
Power Dissipation	P_D	20		W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +200		°C
Thermal Resistance	Θ_{JC}	8.75		°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

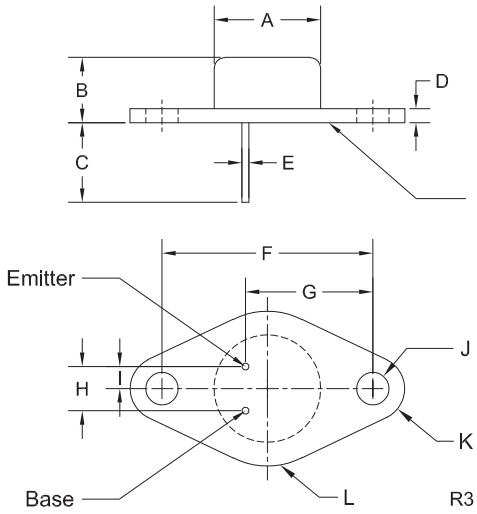
SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_{CBO}	V_{CB}=250V (2N6424)		0.1	mA
I_{CBO}	V_{CB}=325V (2N6425)		0.1	mA
I_{CEV}	V_{CE}=250V, V_{BE}=1.5V (2N6424)		0.5	mA
I_{CEV}	V_{CE}=300V, V_{BE}=1.5V (2N6425)		0.5	mA
I_{CEV}	V_{CE}=125V, V_{BE}=1.5V, T_C=100°C (2N6424)		1.0	mA
I_{CEV}	V_{CE}=200V, V_{BE}=1.5V, T_C=100°C (2N6425)		1.0	mA
I_{CEO}	V_{CE}=125V (2N6424)		0.25	mA
I_{CEO}	V_{CE}=200V (2N6425)		0.25	mA
I_{EBO}	V_{EB}=6.0V		0.1	mA
BV_{CEO}	I_C=5.0mA, (2N6424)	225		V
BV_{CEO}	I_C=5.0mA, (2N6425)	300		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=250A, I_B=25mA		2.5	V
$V_{BE(ON)}$	V_{CE}=10V, I_C=100mA		1.0	V
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=50mA	30		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=100mA	40	200	
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=250mA	25		
h_{fe}	V_{CE}=20V, I_C=100mA, f=1.0kHz	35		
f_T	V_{CE}=10V, I_C=100mA, f=10MHz	10		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz		120	pF

R1 (2-September 2014)

2N6424
2N6425

SILICON
PNP POWER TRANSISTORS

TO-66 CASE - MECHANICAL OUTLINE



Seating Plane:
The seating plane must be within 0.001" concave to 0.004" convex within 0.600" diameter from the center of the device.

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.470	0.500	11.94	12.70
B	0.250	0.340	6.35	8.64
C	0.360	-	9.14	-
D	0.050	0.075	1.27	1.91
E (DIA)	0.028	0.034	0.71	0.86
F	0.956	0.964	24.28	24.48
G	0.570	0.590	14.48	14.99
H	0.190	0.210	4.83	5.33
I	0.093	0.107	2.36	2.72
J (DIA)	0.142	0.152	3.61	3.86
K (RAD)	0.141		3.58	
L (RAD)	0.345		8.76	

TO-66 (REV:R3)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9